1P037

ニトロニルニトロキシドラジカルを導入したサリチリデンアニリン およびそのニトリドクロム(V)錯体の構造と磁気特性 (慶應大理工) 〇中込森,三浦洋平,吉岡直樹

Magneto-Structural Correlation in Salicylidene-4-(nitronyl nitroxide)aniline and Its Chromium(V) Nitride Complex

(Keio Univ) OShin Nakagome, Youhei Miura, Naoki Yoshioka

【緒言】V=OおよびCr=Nユニットを含むシッフ塩基錯体は、 エカトリアル位に位置するシッフ塩基配位子の構造に依存し て、アキシアル配位を経由して多量化することが知られてい る<sup>[1,2]</sup>。一次元鎖構造を形成するCr(V)N錯体はこれまで四座キ レート配位錯体のみ報告されているが、当研究室では、4位に ハロゲンを置換したサリチリデンアニリンを配位子とする二 座配位Cr(V)N錯体が、同様の多量体構造をとることを見出し た<sup>[3]</sup>(Figure 1)。

本研究では、分子間・分子内でのスピン相互作用を期待し、ハ ロゲン同様電子吸引性のニトロニルニトロキシドラジカルを配 位子に導入した Cr(V)N 錯体 1(Scheme 1)を合成した。この配位子 および錯体の構造と磁気特性について検討した。



Figure 1 Crystal packing of bidentate Cr(V)N complex.



Scheme 1

【実験】**Scheme 2** に従い **1**, **2** を合成した。既報<sup>[4]</sup>の、窒素原 子移動反応を利用して Cr=N ユニットを導入し、**1** を合成した。



Scheme 2

【結果と考察】 X線構造解析より1は多量体を形成せず、 モノマー構造をとっていた(Figure 2)。NONO 配位平面から Cr の浮き上がり距離は0.497 Åであり(Figure 3)、連鎖形成 する Cr(V)N 錯体(= 0.400 Å)よりも長く、単核構造(= 0.490 Å)をとる Cr(V)N 錯体と近かった。また、ニトロニル ニトロキシドのテトラメチル部位水素が、負の大きなスピ ン密度を有するアキシアル窒素と接近しているため、分子 間反強磁性的相互作用が予想される。一方、2 はニトロニル ニトロキシドの NO 部位が、テトラメチル部位水素と接近 しているため(Figure 4)、分子間で強磁性的なスピン整列が 予測される。

SQUID 磁気測定より、1 では反強磁性的相互作用が存在 することが示された(Figure 5)。このことから、分子内にお ける金属-ラジカル間スピン相互作用が支配的であること が示唆された。また DFT 計算(ULSDA/6-311G\*\* for Cr and 6-31G\* for other atoms)からも、二重項状態の方が安定であ り、分子内の反強磁性的に相互作用が示唆された。一方、2 では分子間で強磁性的相互作用を発現していることが示さ れた。このことは、分子の接近から予測される結果と一致 した。

【結論】

・ニトロニルニトロキシドを導入した二座配位シッフ塩基 Cr(V)N 錯体 1 を合成した。

・X線構造解析より、1はモノマー構造をとっていた。

・SQUID 磁気測定の結果、1 は反強磁性的相互作用が支配的であったが、2 では分子間の強磁性的相互作用が示唆された。

【参考文献】

[1] (a) M.Mathew, et al., J. Am. Chem. Soc., 92, 3197 (1970). (b)
M.Tsuchimoto, N. Yoshioka, Chem. Phys. Lett., 297, 115 (1998).
[2] M.Tsuchimoto, N. Yoshioka, S. Ohba, Eur. J. Inorg. Chem., 1045 (2001).

[3]中込 他, 第25回基礎有機化学討論会, 2P060 (2014年9月, 仙台)

[4] B. Torben, J. Bendix, Inorg. Chem, 42, 7609 (2003).



Figure 2. Crystal packing of 1



Figure 3. Crystal structure of 1



Figure 4. Crystal structure of 2



dependence of  $\chi_{\rm m}T$  ( $\circ$ ) and  $\chi_{\rm m}^{-1}$  ( $\triangle$ ) for **1** under the applied field of 5000 Oe (1.8 – 300 K)